ペンタセン単結晶表面上に C₆₀を積層した有機 pn ヘテロ接合の電子構造

Electronic Structure of a C₆₀ / Pentacene-Single-Crystal pn-Heterojunction

千葉大院融合¹,千葉大先進²,高エネ研物構研³

^O山本 真之¹, 浦上 裕希¹, 間瀬 一彦³, Kaveenga Rasika Koswattage², 中山 泰生¹, 石井 久夫^{1,2}

AIS, Chiba Univ.¹, CFS, Chiba Univ.², IMSS, KEK.³

^oMasayuki Yamamoto¹, Yuki Uragami¹, Kazuhiko Mase³,

Kaveenga Rasika Koswattage², Yasuo Nakayama¹, and Hisao Ishii^{1,2}

E-mail: masayuki105@chiba-u.jp

有機半導体デバイスは、低コスト、フレキシブル、軽量などの利点により多くの研究者の注目 を集めている。高効率な有機デバイスを実現するために、素子内のヘテロ界面、特に pn ヘテロ接 合における電子構造を理解することは重要である。ペンタセン($C_{22}H_{14}$)および C_{60} は、それぞれ典 型的な p 型, n 型有機半導体材料として知られており、両者のヘテロ界面についてもこれまでに 多くの研究例が報告されている[1-3]。しかし、過去の研究の多くは多様なファセット面が表面に 露出したペンタセン多結晶膜上に C_{60} を成膜した界面に対して行われたもので、界面電子構造を 接合部の分子配向まで含めて詳細に決定、制御した例はない。本研究では、ペンタセン単結晶

(Pn-SC)の表面上に C₆₀ を積層して構造的に高秩序な有機/有機 pn ヘテロ界面を作製し,その電子構造を紫外光電子分光(UPS) および X 線光電子分光 (XPS) により実測した。

UPS および XPS 測定は高エネルギー加速器研究機構フォトンファクトリー(KEK, PF) BL-13B において行った[4]。Pn-SC は物理気相成長法により育成し[5],金コート Si 基板上に銀ペーストで固定して試料を作製した。 C_{60} の真空蒸着は, 1.0×10^{-5} Pa の高真空下において,0.2 - 0.4 nm/min の蒸着速度で行った。

Pn-SC および C₆₀ / Pn-SC 界面の最高占有分子軌道 (HOMO) 領 域,および試料電圧-5Vを印加して計測した二次電子カットオフ (SECO) 領域の UPS スペクトルを Fig.1 に示す。C₆₀ 層蒸着前の Pn-SC の HOMO の立ち上がりは結合エネルギー(BE) = 0.58 (± 0.03) eV と見積もられるが、C60の積層に従って最大で 0.17 (± 0.03) eV 低 BE 側にシフトする。SECO も同じ方向へ 0.13 (±0.03) eV シフトしており, C60の堆積に伴って Pn-SC にバンドの曲がり が誘起されていることが示唆される。Fig.2 に, 試料電圧+100 V を印加して計測した C₆₀ / Pn-SC 界面の C1s 領域の XPS スペクト ルを示す。C60および Pn-SC の C1s ピークは明確に分離しており, C₆₀の積層に伴う両者の内殻準位シフトから, pn ヘテロ界面の形 成に伴うそれぞれの材料層内部でのバンドの曲がりを独立に見 積もることが出来る。膜厚が増加するに従って C60の Cls ピーク 位置が高 BE 側にシフトしていることは、ペンタセンとの界面へ 向けて下向きのバンドの曲がりが生じていることを示している。 本講演では界面でのエネルギー準位接続の詳細についても報告 する。

本研究は、泉科学技術振興財団、科学研究費補助金、および最 先端研究開発支援プログラムの資金助成のもとで行われた。

- [1] I. Salzmann et al., Appl. Phys. 104, 114518 (2008).
- [2] S. J. Kang *et al.*, *Synthetic Metals* **156**, 32 (2006).
- [3] S. Verlaak et al., Adv. Funct. Mater. 19, 3809 (2009).
- [4] A. Toyoshima et al., J. Phys: Conf. Series 425,152019 (2013)
- [5] R. Laudise et al., J. Cryst. Growth 187, 449 (1998).



Fig.1 UPS spectra of C_{60} (x nm) on pentacene SC substrate



